

a 2004 0096

Invenția se referă la optoelectronică, în particular la lentile cu gradient al indicelui de refracție.

Esența invenției constă în faptul că într-un substrat de semiconductor se implantează ioni cu o doză de energie înaltă, determinată de relația

$$D = \alpha R^2,$$

unde:

D – doza energiei înalte a ionilor implantați,

R – distanța de la centru până la periferia stratului,

α – gradientul dozei,

apoi se efectuează decaparea electrochimică.

Revendicări: 1

Figuri: 1